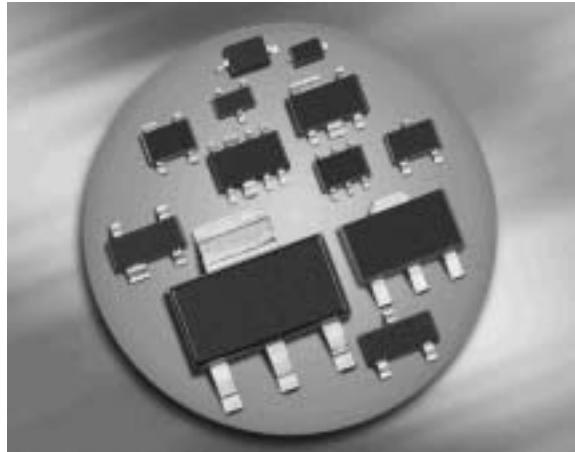
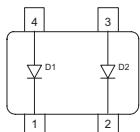


Silicon Switching Diode

- Electrically insulated high-voltage medium-speed diodes
- Pb-free (RoHS compliant) package¹⁾
- Qualified according AEC Q101



BAW101



Type	Package	Configuration	Marking
BAW101	SOT143	parallel	JPs

Maximum Ratings at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Value	Unit
Diode reverse voltage	V_R	300	V
Peak reverse voltage	V_{RM}	300	
Forward current	I_F	250	mA
Peak forward current	I_{FM}	500	
Peak forward current	I_{FM}	500	mA
Surge forward current, $t = 1 \mu\text{s}$	I_{FS}	4.5	A
Non-repetitive peak surge forward current	I_{FSM}	-	
Total power dissipation $T_S \leq 35^\circ\text{C}$	P_{tot}	350	mW
Junction temperature	T_j	150	°C
Storage temperature	T_{stg}	-65 ... 150	

¹Pb-containing package may be available upon special request

Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ¹⁾ BAW101	R_{thJS}	≤ 330	K/W

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

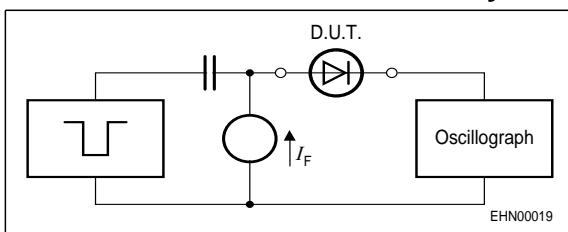
Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	

DC Characteristics

Breakdown voltage $I_{(BR)} = 100 \mu\text{A}$	$V_{(\text{BR})}$	300	-	-	V
Reverse current $V_R = 250 \text{ V}$ $V_R = 250 \text{ V}, T_A = 150^\circ\text{C}$	I_R	-	-	0.15 50	μA
Forward voltage $I_F = 100 \text{ mA}$	V_F	-	-	1.3	V

AC Characteristics

Diode capacitance $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	C_T	-	6	-	pF
Reverse recovery time $I_F = 10 \text{ mA}, I_R = 10 \text{ mA}$, measured at $I_R = 1 \text{ mA}$, $R_L = 100 \Omega$	t_{rr}	-	1	-	μs

Test circuit for reverse recovery time


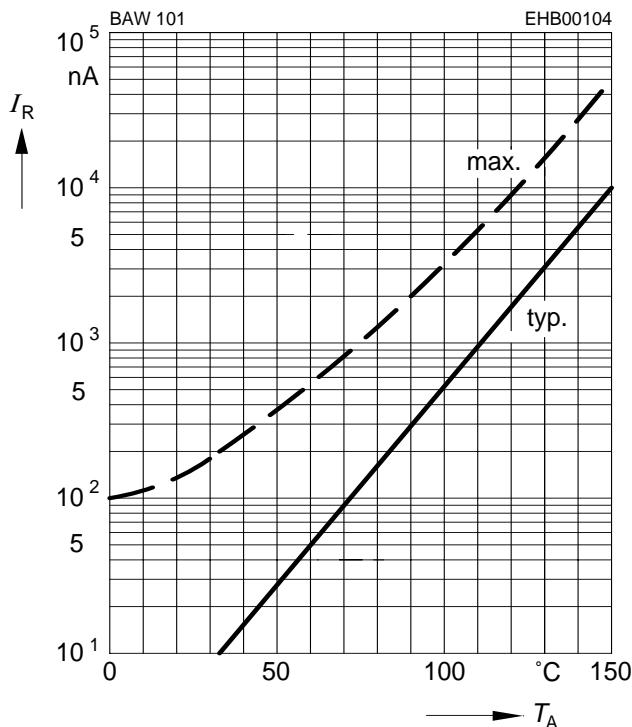
Pulse generator: $t_p = 10\mu\text{s}$, $D = 0.05$, $t_r = 0.6\text{ns}$,
 $R_i = 50\Omega$

Oscilloscope: $R = 50\Omega$, $t_f = 0.35\text{ns}$, $C \leq 1\text{pF}$

¹For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note Thermal Resistance

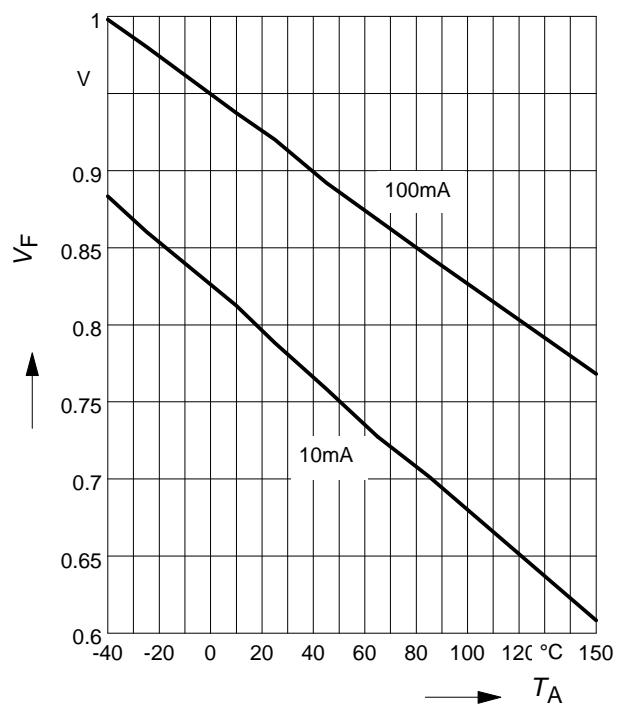
Reverse current $I_R = f(T_A)$

$V_R = 250V$



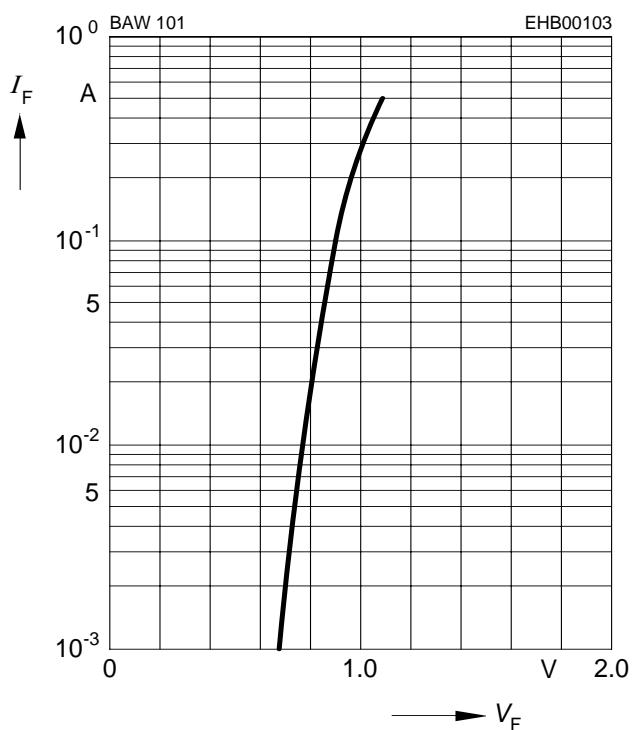
Forward Voltage $V_F = f(T_A)$

I_F = Parameter



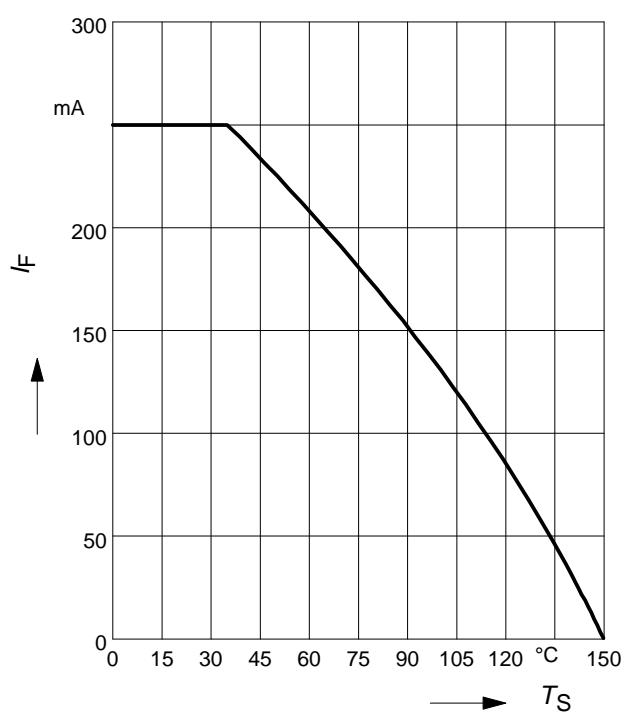
Forward current $I_F = f(V_F)$

$T_A = 25^\circ C$

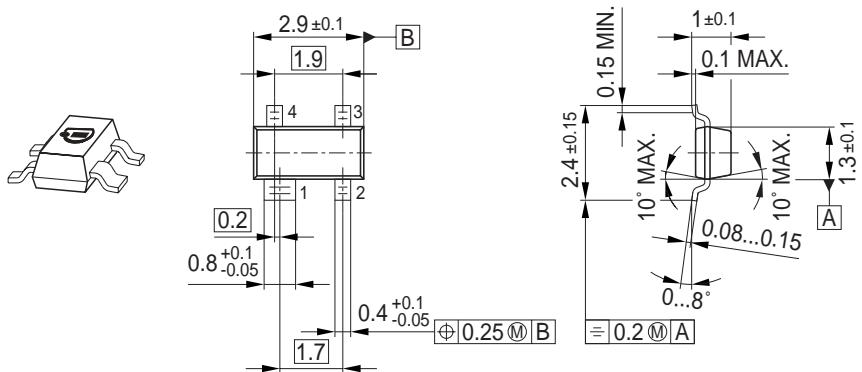


Forward current $I_F = f(T_S)$

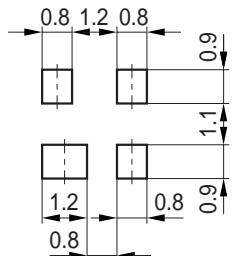
BAW101



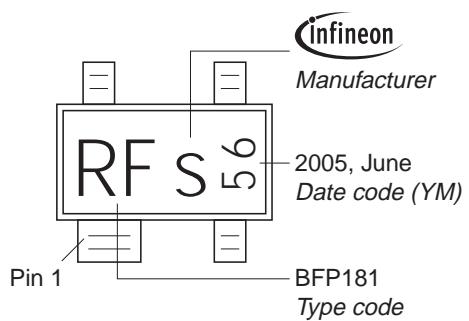
Package Outline



Foot Print

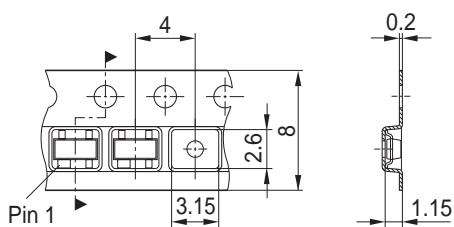


Marking Layout (Example)



Standard Packing

Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
 Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel



Edition 2006-02-01

Published by

Infineon Technologies AG

81726 München, Germany

© Infineon Technologies AG 2007.

All Rights Reserved.

Attention please!

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies Components may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect the safety or effectiveness of that device or system.

Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body, or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Данный компонент на территории Российской Федерации**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru
moschip.ru_4

moschip.ru_6
moschip.ru_9